МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Кафедра неорганічної та фізичної хімії

На правах рукопису

ЗІНИЧ ІРИНА БОГДАНІВНА

Фізико-хімічна взаємодія в системі

 $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$

Спеціальність: 102 Хімія Освітня програма: Хімія Робота на здобуття освітнього рівня «Магістр»

> Науковий керівник: ПІСКАЧ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА кандидат хімічних наук, професор

РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАХИСТУ Протокол № _____ засідання кафедри неорганічної та фізичної хімії від _____20_ р

Завідувач кафедри проф. Гулай Л. Д.

ЛУЦЬК – 2024

АНОТАЦІЯ

Зінич І.Б. Фізико-хімічна взаємодія в системі Ag₂S – Ag₄P₂S₇ – GeS₂. Магістерська робота на здобуття освітнього ступення магістра. Спеціальність 102 Хімія. Освітньо-професійна програма: Хімія. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 52 с.

В багатокомпонентній системі $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$ підтвердження існування таких сполук: Ag_8GeS_6 , Ag_2GeS_3 , Ag_4GeS_4 , Ag_7PS_6 , Ag_3PS_4 , $Ag_7P_3S_{11}$, $Ag_4P_2S_7$. В цій системі одна із сполук ($Ag_7P_3S_{11}$) існує вище 574 K, тому в роботі встановлені фазові рівноваги між заявленими сполуками при 670 K, на відмінно від дослідженої при 500 K. За результатами РФА побудовано ізотермічний переріз підсистеми $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$ при 670 K, де виявлено 8 однофазних полів (Ag_2S , $\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$, ζ - Ag_3PS_4 , $Ag_7P_3S_{11}$, $Ag_4P_2S_7$, $Ag_{10}Ge_3S_{11}$, Ag_2GeS_3 , GeS_2) утворюють 12 областей двофазних рівноваг ($Ag_2S + \delta$ '- $Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$, $\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$, ζ - $Ag_3PS_4 + Ag_7P_3S_{11}$, $Ag_7P_3S_{11} + Ag_4P_2S_7$, $\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6 + Ag_{10}Ge_3S_{11}$, $Ag_{10}Ge_3S_{11} + Ag_2GeS_3$, $Ag_2GeS_3 + GeS_2$,

 ζ -Ag₃PS₄+Ag₁₀Ge₃S₁₁, ζ -Ag₃PS₄+Ag₂GeS₃, ζ -Ag₃PS₄+GeS₂, Ag₇P₃S₁₁+GeS₂, Ag₄P₂S₇+GeS₂), які поділяють концентраційний трикутник на 5 полів трифазних взаємодій (ζ -Ag₃PS₄+Ag₁₀Ge₃S₁₁+ δ '-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆,

 $\zeta - Ag_3 PS_4 + Ag_{10}Ge_3S_{11} + Ag_2GeS_3, \zeta - Ag_3 PS_4 + Ag_2GeS_3 + GeS_2, Ag_7 P_3 S_{11} + \zeta - Ag_3 PS_4 + GeS_2, Ag_4 P_2 S_7 + Ag_7 P_3 S_{11} + GeS_2).$

Побудовано політермічний переріз $Ag_3PS_4 - Ag_8GeS_6$. Цей переріз є двофазною рівновагою в підсолідусній області. Крива первинної кристалізації твердого розчину δ'- $Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$ (кубічна структуру ПГ *F*-43*m*) опускається від ліквідусу сполуки Ag_8GeS_6 до точки ліквідусу складу сполуки Ag_3PS_4 . Від температури перитектики з обмежуючої (857 K), якій відповідає процес L+ $Ag_7PS_6 \leftrightarrow Ag_7P_3S_{11}$ перерізу $Ag_2S - P_4S_{10}(P_2S_5)$, опускається крива вторинної кристалізації L+ δ'- $Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6 + Ag_7P_3S_{11}$ на перитектичну площину процесу L+ δ' - $Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6 \leftrightarrow \delta'$ - $Ag_3PS_4 + Ag_{10}Ge_3S_{11}$. Горизонталь при 803 К належить твердофазному утворенню Ag_3PS_4 . Розчинність на основі Ag_8GeS_6 становить

~40 мол. % при температурі відпалу (670 К). Від 493 К починається евтектоїдно розпадатися BTM-Ag₈GeS₆ (δ' - Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆ \leftrightarrow Ag₃PS₄+ δ' -Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆).

Також побудовано проекції поверхонь ліквідуса двох підсистем $Ag_2S - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ і $Ag_3PS_4 - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ з використанням літературних даних по обмежуючих $Ag_2S - Ag_4P_2S_7$, $Ag_2S - GeS_2$ та по результатах власних досліджень політермічного перерізу $Ag_3PS_4 - Ag_8GeS_6$. Побудовано діаграма стану системи $Ag_2S - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ відноситься до типу діаграм стану з моноваріантною евтектичною рівновагою $L \leftrightarrow BTM-Ag_2S + \delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$, що обмежена двома квазіподвійними системами $Ag_2S - Ag_7PS_6$ та $Ag_2S - Ag_8GeS_6$ евтектичного типу, та системою $Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$, в якій утворюються неперервні ряди твердих розчинів ($\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$ -твердий розчин) на основі тернарних сполук. Проекція поверхні ліквідуса наступної підсистеми $Ag_3PS_4 - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ складається з одного поля первинної кристалізації фази $\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$ твердого розчину, що утворюється між BTM сполук Ag_7PS_6 та Ag_3PS_6 та Ag_3QS_6 складається з одного поля первинної кристалізації фази δ'

Ключові слова: фізико-хімічна взаємодія, сульфіди, фазові переходи, квазіпотрійні системи, тверді розчини.

ANNOTATION

Zinich I.B. Physicochemical Interaction in the System $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$. Master's Thesis for obtaining the Master's degree in Chemistry. Specialty 102 Chemistry. Educational and Professional Program: Chemistry. Lesya Ukrainka Volyn National University. Lutsk, 2024. 52 p.

This work confirms the existence of the following compounds in the multicomponent system $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$: Ag_8GeS_6 , Ag_2GeS_3 , Ag_4GeS_4 , Ag_7PS_6 , Ag_3PS_4 , $Ag_7P_3S_{11}$, $Ag_4P_2S_7$. One of these compounds $(Ag_7P_3S_{11})$ exists at temperatures above 574 K, so phase equilibria between the listed compounds were established at 670 K, differing from the ones investigated at 500 K. Based on the X-ray diffraction analysis, an isothermal section of the $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$ subsystem at 670 K was constructed, revealing 8 single-phase fields $(Ag_2S, \delta$ '- $Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$, ζ - Ag_3PS_4 , $Ag_7P_3S_{11}$, $Ag_4P_2S_7$, $Ag_{10}Ge_3S_{11}$, Ag_2GeS_3 , GeS_2), which form 12 regions of two-phase equilibria $(Ag_2S + \delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6 + \zeta-Ag_3PS_4,$

 $\begin{aligned} &\zeta - Ag_3 PS_4 + Ag_7 P_3 S_{11}, & Ag_7 P_3 S_{11} + Ag_4 P_2 S_7, & \delta' - Ag_{8-x} Ge_{1-x} P_x S_6 + Ag_{10} Ge_3 S_{11}, \\ &Ag_{10} Ge_3 S_{11} + Ag_2 GeS_3, &Ag_2 GeS_3 + GeS_2, &\zeta - Ag_3 PS_4 + Ag_{10} Ge_3 S_{11}, &\zeta - Ag_3 PS_4 + Ag_2 GeS_3, \\ &\zeta - Ag_3 PS_4 + GeS_2, & Ag_7 P_3 S_{11} + GeS_2, & Ag_4 P_2 S_7 + GeS_2), \\ &\text{which divide the concentration triangle into 5 three-phase interaction fields ($\zeta - Ag_3 PS_4 + Ag_{10} Ge_3 S_{11} + \delta$ \\ &' - Ag_{8-x} Ge_{1-x} P_x S_6, & &\zeta - Ag_3 PS_4 + Ag_{10} Ge_3 S_{11} + Ag_2 GeS_3, &\zeta - Ag_3 PS_4 + Ag_2 GeS_3 + GeS_2, \\ &Ag_7 P_3 S_{11} + &\zeta - Ag_3 PS_4 + GeS_2, &Ag_4 P_2 S_7 + Ag_7 P_3 S_{11} + GeS_2). \end{aligned}$

A polythermal section was constructed $Ag_3PS_4 - Ag_8GeS_6$. This section represents a two-phase equilibrium in the subsolidus region. The primary crystallization curve of the solid solution $\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$ (cubic structure PG *F*-43m) descends from the liquidus of the compound Ag_8GeS_6 to the liquidus point of the Ag_3PS_4 compound. From the temperature of the peritectic limiting (857 K), corresponding to the process L+Ag₇PS6 \leftrightarrow Ag₇P₃S₁₁ in the Ag₂S - P₄S₁₀ (P₂S₅) system, the secondary crystallization curve L+ δ' -Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆ \leftrightarrow δ' -Ag₃PS₄+Ag₁₀Ge₃S₁₁. The

4

horizontal line at 803 K corresponds to the solid-phase formation of Ag_3PS_4 . The solubility based on Ag_8GeS_6 is approximately 40 mol.% at the annealing temperature (670 K). Starting from 493 K, the WTM- Ag_8GeS_6 begins to eutectoid decompose

 $(\delta' - Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6 \leftrightarrow Ag_3PS_4 + \delta' - Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6).$

Projections of the liquidus surfaces of two subsystems, $Ag_2S - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ and $Ag_3PS_4 - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$, were also constructed using literature data on the limiting systems $Ag_2S - Ag_4P_2S_7$, $Ag_2S - GeS_2$, and the results of our own studies on the polythermal section of $Ag_3PS_4 - Ag_8GeS_6$. The phase diagram of the $Ag_2S - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ system corresponds to a type of state diagram with a monovariant eutectic equilibrium L \leftrightarrow WTM- Ag_2S + δ' - Ag_8 - Ag_6GeS_6 , and the Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6 system, in which continuous series of solid solutions (δ' - $Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$ solid solution) based on ternary compounds are formed. The projection of the liquidus surface of the next subsystem $Ag_3PS_4 - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ consists of one primary crystallization field of the phase δ' - $Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$ - solid solution, which forms between the WTM compounds Ag_7PS_6 and Ag_3GeS_6 with a cubic structure (PG F-43m).

Keywords: physicochemical interaction, sulfides, phase transitions, quasitriangular systems, solid solutions.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	8
ВСТУП	9
РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	11
1.1. Характеристика вихідних речовин	11
1.1.1. Аргентум	11
1.1.2. Германій	12
1.1.3. Фосфор	13
1.1.4. Сульфур	14
1.2. Характеристика фазових діаграм та властивості сполук	16
1.2.1. Характеристика бінарних систем	16
1.2.1.1. Система Ag – S	16
1.2.1.2. Система Ge – S	18
1.2.2. Квазібінарні системи	19
1.2.2.1. Система Ag ₂ S – GeS ₂	19
1.2.2.2. Система Ag ₂ S – P ₂ S ₅	21
1.2.2.3. Ізотермічний переріз системи Ag ₂ S – GeS ₂ – P ₂ S ₅	23
1.2.2.4. Система Ag ₈ GeS ₆ – Ag ₇ PS ₆	24
Висновки з літературного огляду	24
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ	
2.1. Характеристика вихідних речовин та методів синтезу	
2.2. Ренттенофазовий аналіз	27
2.3. Диференціально-термічний аналіз (ДТА)	29
Висновки до методики експерименту	31
РОЗДІЛ З. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА	32
3.1. Ізотермічний переріз системи при 670 К	32
3.2. Політермічний переріз Ag ₃ PS ₄ – Ag ₈ GeS ₆	35
3.3. Проекція поверхонь ліквідуса	
3.3.1. Підсистема Ag ₂ S – Ag ₇ PS ₆ – Ag ₈ GeS ₆	
3.3.2. Підсистема Ag ₃ PS ₄ – Ag ₇ PS ₆ – Ag ₈ GeS ₆	40
Висновки експериментальної частини	41
ВИСНОВКИ	
	6

3MICT

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	45
ДОДАТКИ	

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ДРОН 4-13 – дифрактометр рентгенівський;

- КЧ координаційне число;
- СТ структурний тип;
- СП символ Пірсона;
- *а*, *b*, *c*, параметри елементарної комірки;
- α, β, γ-різні модифікації однієї речовини.
- Л-ра літературне джерело;
- ПГ просторова група;
- ПСТ правильна система точок;

Рис – рисунок;

- НТМ низькотемпературна модифікація
- ВТМ високотемпературна модифікація

ВСТУП

Актуальність теми. На даний час новітні технології потребують багато нових перспективних матеріалів, які в першу чергу містять елементи, що поширені в природі та дешеві. Наприклад сполуки сімейства аргіродитів складу Ag_7PS_6 та Ag_8GeS_6 мають загальну рису – фазові переходи від низькотемпературних модифікацій впорядкованих до високотемпературних модифікацій невпорядкованих структур. Ці та аналогічні аргентумовмісні досліджуються, оскільки халькогеніди активно цікавими £ напівпровідниковими матеріалами з нелінійно-оптичними, фото-електричними, термоелектричними та іншими властивостями. Деякі з цих сполук є твердими суперіонними провідниками, які знайшли використання в іон селективних електродах, твердих електролітах тощо. Дослідження взаємодії між відомими перспективними сполуками допомагає виявляти такі матеріали з унікальними властивостями, а також оптимізувати процеси їх одержання за допомогою більш ефективних технологій. Вивчення кристалічної структури фаз квазіпотрійної системи Ag₂S – Ag₄P₂S₇ – GeS₂ дає можливість з'ясувати природу хімічної взаємодії компонентів у досліджуваній системі та прогнозувати в системах аналогічного типу.

<u>Мета і завдання дослідження.</u> Метою дослідження є вивчення закономірностей фізико-хімічних взаємодій в системі $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$. Досягнення мети в роботі потребує вирішення таких завдань: синтезувати сплави досліджуваної системи; рентгенофазовий (РФА) та диференціально-термічний (ДТА) аналіз отриманих сплавів; вивчити характер взаємодії у системі $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$ шляхом експериментального дослідження ізотермічного, політермічного перерізів, побудови проекцій поверхонь луквідусу.

<u>Предмет дослідження.</u> Ізотермічний при 670 К, політермічни ($Ag_3PS_4 - Ag_8GeS_6$) перерізи, деякі проекції поверхонь луквідусу системи $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$.

Об'єкт дослідження. Фізико-хімічна взаємодія в системі Ag₂S – Ag₄P₂S₇

9

 $-\operatorname{GeS}_2$.

<u>Методи дослідження.</u> Рентгенофазовий аналіз, диференціальнотермічний аналіз.

<u>Апробація результатів та публікації.</u> За деякими матеріалами роботи опубліковані тези в матеріалах VIII Міжнародної науково-практичної конференції «ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА: СТАН, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 18-19 жовтня 2024 р., м. Луцьк (Березнюк О.П., Зінич І.Б., Невидюк В.С., Алрікік М., Піскач Л.В. Взаємодія германій(станум)(IV) та фосфор(V) сульфідів з високим вмістом аргентум(I) сульфіду при 500 К. С. 12-13).

РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

1.1. Характеристика вихідних речовин

1.1.1. Аргентум [1]

Аргентум (срібло) – хімічний елемент, символ якого Ag, з атомним номером 47, атомна маса 107, 8682 а.о.м. Срібло має сріблясто-білий колір, дуже блискучий і вражає своєю красою.

Він є досить м'яким металом. Це благородний метал, який відомий своєю високою провідністю електричного струму, чистому y вигляді утворює хімічну речовину срібло (рис.1.1.). Аргентум має два стабільних ізотопи: Ag^{107} Ag^{109} . Найбільш поширеним ізотопом є Ag¹⁰⁷, який складає більше 50% від усіх





ізотопів Аргентуму на Землі. Інший стабільний ізотоп Ag¹⁰⁹ складає близько 48% від усіх ізотопів срібла.

Одержання

Метал міститься в земній корі в чистому, вільному елементарному вигляді («самородне срібло»), як сплав із золотом та іншими металами, а також у таких мінералах, як аргентит і хлораргірит. Більшість срібла виробляється як побічний продукт при переробці міді, золота, свинцю та цинку.

Хімічні властивості

Срібло не розчиняється у воді і має низьку розчинность у більшості розчинників.

Срібло легко реагує з сульфуровмісними сполуками, такими як сірководень (H₂S) або сульфіди, що може призвести до почорніння поверхні срібла.

Срібло реагує з кислотами, наприклад, з розбавленою хлоридною або нітратною кислотами. В результаті цієї реакції утворюється арґентум хлорид (AgCl) або арґентум нітрат (AgNO₃). Ці реакції використовуються в лабораторній практиці.

Срібло також може реагувати з деякими органічними сполуками, такими як аміни, що призводить до утворення арґентумовмісних солей:

$$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow.$$

Застосування

Срібло використовується для виготовлення прикрас, посуду та столових приборів, фоточутливих матеріалів, таких як плівка та фотопапір. Воно використовується для виготовлення медичних виів та інструментів, таких як стерилізатори, катетери та інше. Також срібло має антибактеріальні властивості та використовується для виготовлення мазей, кремів та інших медичних препаратів.

1.1.2 Германій [2]

Германій – хімічний елемент, символ якого Ge, з атомним номером 32, атомна маса 72.63 а.о.м. Крихкий сріблясто білий металоїд (рис 1. 2.).

Найпоширеніший напівпровідник.

Одержання

Джерелами Германію є поліметалічні викопне вугілля i деякі руди, типи вулканогенно-осадового залізняку. Три чверті Германію отримують як супутній виробництві продукт при цинку 3 сфалеритових концентратів, а решту – з



Рис. 1.2. Германій

надсмольних вод під час коксування

вугілля

з попелу енергетичного вугілля. Невелику частку добувають з магнетитових концентратів.

При певних умовах спалювання вугілля вміст германію у золі збільшується у 10-100 разів у порівнянні з вихідним. Для вилучення германію із золи використовується його властивість легкого перегону при температурі коксування. Після конденсації рідких продуктів коксування сполуки германію конденсуються у пірогенетичній воді і смолі. Крім того, висока концентрація германію спостерігається у генераторному пилу при газифікації вугілля.

У 2017 році у світі було видобуто 134 тони германію, з яких 88 – у Китаї.

Близько 30 % германію отримується завдяки вторинній переробці.

1.1.3 Фосфор [3]

Фосфор - хімічний елемент, символ якого Р, з атомним номером 15, атомна маса 30,97376 а.о.м. Неметал, і може існувати у різних аллотропних формах, таких як білий фосфор, червоний фосфор та чорний фосфор. Елемент, який дуже поширений у земній корі. Через високу хімічну активність у земній корі у вільному стані не зустрічається. Фосфор є важливим елементом для життя, оскільки він є складовою частиною нуклеїнових кислот та фосфоліпідів, необхідних для клітинного метаболізму.

Одержання

Фосфати є основним джерелом фосфору і можуть бути видобуті з фосфатних руд, таких як апатит. Цей процес включає в себе подрібнення руди, обробку її хімічними реагентами та виділення фосфору у вигляді фосфатів.

Фосфати можуть бути піддані



термічному розкладу для виділення Рис. 1.3. Фосфор елементарного Фосфору.

В цьому процесі для розкладу фосфатів та одержання фосфору використовується висока температуру.

Хімічні властивості

Фосфор може реагувати з киснем, утворюючи оксиди фосфору; реагує з водою, утворюючи фосфідні сполуки та фосфористу кислоту; з кислотами, утворюючи солі фосфатної кислоти; з лугами, утворюючи фосфіди та гідроксид фосфору:

$$4P+5O_2=P_2O_5$$
; $2P+8H_2O\rightarrow 2H_3PO_4+5H_2\uparrow$.

Застосування

Фосфор використовується в промисловості для виробництва добрив, пластмас, фарб, піротехнічних матеріалів та інших продуктів. Він також використовується в сільському господарстві для підживлення рослин та в медицині для виробництва лікарських препаратів. Він також може бути використаний у вигляді фосфористої кислоти для виробництва різних хімічних продуктів.

Правила техніки безпеки при роботі з фосфором наведенні в додатку 1.

1.1.4 Сульфур [4]

Сульфур - хімічний елемент, символ якого S, з атомним номером 16, атомна маса 32,066 а.о.м. Проста речовина – сірка, жовта кристалічна речовина (рис.1.4).

Вона є неметалом і може існувати у різних аллотропних формах, включаючи кристалічну сірку, аморфну сірку та молекулярну сірку. Сірка € важливим компонентом багатьох органічних сполук, таких як амінокислоти, вітаміни та гормони. В природі



Рис. 1.4. Сірка

трапляється у самородному стані у вигляді сульфідів важких металів, піритів.

Одержання

Сірка може бути видобута з сірчистих руд, таких як пірит або гіпс. Цей процес включає в себе подрібнення руди, обробку її хімічними реагентами та відокремлення сірки від інших компонентів. Сульфатна кислота також може бути використана для одержання сірки. Цей процес включає в себе окислення сірчистої кислоти або сірчаних сполук для виділення елементарної сірки.

Хімічні властивості

Сірка має характеристичний запах, який може бути відчутний при роботі з нею. Вона також може утворювати різні сполуки з іншими елементами, які мають важливе застосування у промисловості та науці.

Сульфур може мати такі ступені окислення: –2, 0, +2, +4,+6. За високих температур сірка взаємодіє з усіма елементами, за винятком азоту, золота і платини, виявляючи залежно від умов властивості окисника чи відновника. З деякими металами вона взаємодіє під час нагрівання, утворюючи солі - сульфіди. З ртуттю сірка взаємодіє за кімнатної температури. Розтираючи в ступці рідку ртуть з сірчаним порошком, одержують меркурій (II) сульфід. Саме тому розлиту ртуть знешкоджують, засипаючи сіркою. Нагріванням сірки з воднем добувають сірководень:

Застосування

Сірка використовується в промисловості для виробництва сульфітної кислоти, сірчанокислого амонію, сульфатної кислоти та інших хімічних сполук. Вона також використовується у сільському господарстві для вирощування рослин та у фармацевтиці при виробництві лікарських засобів. Сірку застосовують для добування гуми, виготовлення сірників, чорного пороху, бенгальських вогнів.

1.2. Характеристика фазових діаграм та властивості сполук

1.2.1. Характеристика бінарних систем

1.2.1.1. Система Ag – S

Аргентум сульфід Ag₂S утворюється в системі Ag – S при співвідношенні компонентів 2:1. В інтервалі температур від кімнатної до плавлення має три модифікації: моноклінну (α), об'ємноцентровану (β) і гранецентровану кубічну (γ).

Фазова діаграма системи Ag – S представлена на рис. 1.5. Ag₂S є фазою змінного складу при підвищених температурах. В системі існують дві області незмішування в рідкому стані з двома монотектичними точками, що існують в підсистемах Ag – Ag₂S i Ag₂S – S.



Рис.1.5 Фазова діаграма системи Ag – S [5].

1- α -Ag ₂ S	7- $Ag + \alpha - Ag_2S$
2- β -Ag ₂ S	8- $Ag + \beta - Ag_2S$
3- γ -Ag ₂ S	9- $Ag + \gamma - Ag_2S$
4- γ -Ag ₂ S+ L ₄	10-10 - L ₂ +Ag
5- β -Ag ₂ S + L ₄	$11-L_1 + Ag$
6- α - Ag ₂ S + S	

Для системи Ag – S характерні дві евтектичні точки, які зміщені до вихідних компонентів, причому зі сторони Сульфуру евтектика є вироджено. Цю систему можна розглядати як сукупність двох систем Ag – Ag₂S та Ag₂S – S. У кожній в підсистем протікають евтектичні процеси:

 $L \leftrightarrow Ag + \alpha$ -Ag₂S та L $\leftrightarrow \gamma$ -Ag₂S + S відповідно.

Для системи характерні утворення областей твердих розчинів на основі сполуки Ag₂S в трьох модифікаціях залежно від температури.

Температури фазових переходів залежить від ступеня відхилення від стехіометричного складу Ag₂S. Стійкою при кімнатній температурі є моноклінна α-Ag₂S. Атоми Сульфуру розташовані за дещо спотвореним об'ємноцентрованим кубом (ребро куба дорівнює в середньому 4,86 Å з подвоєною віссю, яка паралельна площині. Таким чином, атоми Сульфуру

4

лежать на відстані 0,49 Å приблизно в одній площині, перпендикулярній центру [6].

Частина атомів Арґентуму зміщена від цієї площини (трохи вище або нижче за площину) і координується з трьома атомами Сульфуру, розташованими на відстані 2,50, 2,61 і 2,69 Å. Інші атоми Аргентуму знаходяться між площинами і мають два найближчих сусіди на різних шарах на відстані 2,49 та 2,52 Å.

При кристалізації Ag_2S вище + 273 К утворюються об'ємноцентровані кубічні кристали β- Ag_2S . В структурі β- Ag_2S атоми Сульфуру розташовуються по кутах і в центрі кубічного осередку [0,0, та 1/2, 1/2, 1/2). При швидкому охолодженні монокристали β- Ag_2S , що мають об'ємноцентровану кубічну структуру, переходять в полікристалічний α- Ag_2S моноклінної форми. Після переходу вісь куба зберігається як здвоєна вісь в моноклінній структурі α- Ag_2S . Обидві модифікації Ag_2S мають між собою структурні аналогії: атоми Сульфуру утворюють об'ємноцентрований куб, а атоми Арґентуму частково розташовуються або в центрі подвійної піраміди, утвореної атомами Сульфуру, або в центрі тетраедра. При температурі вище 283 К існує ще одна кубічна модифікація - γ - Ag_2S з гранецентрованим осередком [7].

Для Ag₂S характерна значна зміна електропровідності при температурі фазового переходу + 273 К. З підвищенням температури електропровідність поступово збільшується до 1 ом⁻¹·см⁻¹, при температурі фазового переходу різко зростає до величини 10³ ом^{-1.} см⁻¹ в області існування β-Ag₂S та має металевий характер. Концентрація носіїв струму також різко зростає. Сульфід α-Ag₂S має концентрацію носіїв 10¹⁵-6 ·10¹⁶ см⁻³. У β-Ag₂S при + 273 К концентрація носіїв збільшується до 4.1019 см⁻³. Ширина забороненої зони α-Ag₂S, визначена оптичним методом, має величину 1,34 еВ. Теплопровідність β-Ag₂S різко збільшується, інтервалі температур + 273 К.

Характеристика кристалічної сполуки Ад25 [9]

α-Ag₂S: моноклінна сингонія, просторова група *P*2₁ з параметрами гратки: *a*=0.420, *b*=0.686, *c*= 0.970 нм.

β-Ag₂S: кубічна сингонія, просторова група І*m*-3*m* з параметрами гратки: *a*=0,48914 нм.

γ-Ag₂S: кубічна сингонія, просторова група *Fm-3m* з параметри гратки: *a*=0.634 нм.

1.2.1.2. Система Ge – S

Фазову Т-х діаграму подвійної системи Ge – S опубліковано в роботі [11]. Представлена на рис. 1.6. діаграма по цій системі наведена в роботі [11]. Знайдено дві стійкі хімічні сполуки складів GeS і GeS₂. Згідно роботи [10] в цій системі наведена ще сполука Ge₂S₃. GeS і GeS₂, утворюються конгруентно при + 273 К відповідно (рис. 1.6). Моносульфід германію, утворює евтектику з германієм (L \rightleftharpoons Ge + β -GeS) при + 273 К і складі 48 ат.% S. Моносульфід і дисульфід германію утворюють евтектику при 60 ат.% S (L \rightleftharpoons β -GeS + GeS₂) з температурою плавлення + 273 К. Монотектична реакція (L \rightleftharpoons L₁+L₂) відбувається при 1193 К. В області складів 77-85 ат.% S передбачається друга область розшаровування. Третій евтектичний процес (L \rightleftharpoons GeS₂ + S) протікає при 393 К. Для моносульфіду германію спостерігалися термічні ефекти при 283 К, які автори інтерпретували як фазовий перехід у твердому стані.





Систему можна розглядати як сукупність трьох підсистем з компонентами:

Ge – GeS; GeS – GeS₂; GeS₂ – S. B усіх підсистемах проходять евтектичні нонваріантні процеси з утворенням: у підсистемі Ge – GeS

суміші двох фаз Ge та GeS;

у підсистемі GeS – GeS₂ суміші фаз GeS – GeS₂, а у підсистемі GeS₂ – S наявні GeS₂ + S (остання евтектика при 393 К вироджена).

Основні кристалографічні характеристики GeS₂:

ВТМ-GeS₂ – моноклінна сингонія, ПГ *P2*₁/*c*, параметри гратки: *a*=0.6720, *b*=1.610, *c*= 1.1436 нм, β=90,88° [12];

НТМ-GeS₂ – моноклінна сингонія, ПГ *Pc*, параметри гратки: *a*=0,6875, *b*=2,255, *c*= 0,6809 нм, *β*=120,45° [13]

1.2.2. Квазібінарні системи

1.2.2.1 Система Ag₂S – GeS₂

Система $Ag_2S - GeS_2$ досліджувалась неодноразово [14-17]. Діаграма стану системи $Ag_2S - GeS_2$ представлена на рис. 1.7. [14]. В системі утворюються перспективні потрійні напівпровідникові сполуки Ag_8GeS_6 та Ag_2GeS_3 , які привернули увагу завдяки своїм оптичним, електричним та термічним властивостям з урахуванням можливості їх використання в електронній техніки, в якості фотоелектричних елементів та ін.

Мінерал Ag₈GeS₆ є родоначальником широкого класу сполук аргіродитів [16], що об'єднуються подібною кристалічною структурою та відносяться до тетраедрично щільно упакованих фаз.

Особливості кристалічної аргіродитів структури зумовлюють наявність таких параметрів як високі значення іонної провідності, аномально низької теплопровідності, менші значення ширини забороненої відносить аргіродити до перспективних твердотільних зони, ЩО провідників, термоелектриків, фотоелементів.

Результати робіт є однозначні щодо утворення тернарної сполуки Ag₈GeS₆ з постійним складом. Встановлено, що сполука Ag₈GeS₆ володіє конгруентним характером плавлення в межах 1213-1228 К та має поліморфне перетворення при 473-493 К [17-18].



Згідно [19, 20], сполука Ag₂GeS₃ утворюється за твердофазним процесом при 593 К. Відомо [21], що вона кристалізується в ромбічній структурі. Згідно даних роботи [16] в системі утворюється три сполуки: Ag₂GeS₃ i Ag₈GeS₆

21

конгруентно при 921 К і 1223 К відповідно; Ag_4GeS_4 – інконгруентно за перитектичною реакцією L + α -Ag_8GeS₆ \leftrightarrow Ag₄GeS₄ при 1013 К. Ag₂GeS₃ має поліморфне перетворення при 579 К. Авторами [22] встановлено існування сполуки Ag₁₀Ge₃S₁₁, що є аналогічною за складом до Ag₁₀Si₃S₁₁. Згідно даних [21] сполука Ag₁₀Ge₃S₁₁ є інконгруентною й утворюється відповідно до перитектичної реакції L + α -Ag₈GeS₆ \leftrightarrow Ag₁₀Ge₃S₁₁, яка проходить при 1013 К.

Склади та кристалографічні характеристики усіх відомих сполук системи Ag₂S – GeS₂ подані в табл. 1.3.

Таблиця 1.3.

Спол	ука		HTM-Ag ₈ GeS ₆	BTM-Ag ₈ GeS ₆	Ag ₂ GeS ₃	$Ag_{10}Ge_{3}S_{11}$
ΠГ			$Pna2_1$	<i>F</i> -43 <i>m</i>	$Cmc2_1$	Сс
Сингонія		орторомбічна	кубічна	ромбічна	моноклінна	
СП		oP60	cF60	oC24	mS220	
	Лінійні, нм	a	1,5149	1,070	1,1790	2,6244
аdтэ		b	0,7476		0,7064	0,6502
aM6 ricu		С	1,0589		0,6338	2,5083
Ilar	Кутові					β=109,91°
Л-ра	ı		[23]	[14]	[17]	[24]

Кристалографічні характеристики тернарних сполук системи Ag₂S – GeS₂

1.2.2.2. Система Ag₂S – P₂S₅

Фазові рівноваги в систем $Ag_2S - P_4S_{10}$ [25] наведена на рис. 1.8 у повному інтервалі концентрацій (*a*) та в межах 0-30 мол. % P_4S_{10} (*б*), так як в роботі вихідними компонентами досліджуваної системи є сполуки Ag_2S та $Ag_4P_2S_7$.

В інтервалі 0-30 мол. % P_4S_{10} утворюється чотири тернарні фази (Ag₇PS₆, Ag₇P₃S₁₁, Ag₄P₂S₇ та Ag₃PS₄) із п'яти: Ag₇PS₆, Ag₇P₃S₁₁, Ag₄P₂S₇, AgPS₃, Ag₃PS₄ [25]. Сполука Ag₇PS₆ володіє конгруентним характером плавлення при 1092 К. Дві (Ag₇P₃S₁₁ та Ag₄P₂S₇) володіють інконгруентним характером плавлення і утворюються за перитектичними реакціями при 857 К та 740 К відповідно. Ag₃PS₄ з підвищенням температури перитектоїдно розкладається за реакцією

Ag₃PS₄ ↔ BTM-Ag₇PS₆ + Ag₇P₃S₁₁ при 803 К. Сполука Ag₇P₃S₁₁ охолоджуючись розкладається при 574 К на Ag₃PS₄ та HTM-Ag₄P₂S₇. Ag₇PS₆ та Ag₄P₂S₇ кристалізуються у двох модифікаціях з температурами фазових переходів при 860 та 700 К відповідно. Між Ag₂S та Ag₇PS₆ – евтектична взаємодія L ↔ BTM-Ag₂S + BTM-Ag₇PS₆ при 1011 К, а два перитектичні процеси протікають за реакціями: L + BTM-Ag₇PS₆ ↔ Ag₇P₃S₁₁ (857 K) та L + Ag₇P₃S₁₁ ↔ BTM-Ag₄P₂S₇ (740 K).

Склади та кристалографічні характеристики сполук системи Ag₂S – Ag₄P₂S₇ подані в табл. 1.4. [25, 26-29].



Рис.1.8. Діаграма стану системи Ag₂S – P₄S₁₀(б) [25]: *a* – у повному інтервалі концентрацій; б – в межах 0-30 мол. % P₄S₁₀

Таблиця 1.4

К	ристалограф	ічні	характ	еристики	тернарних	сполук	перерізу	Ag_2	S – <i>I</i>	Ag₄F	P_2	57
---	-------------	------	--------	----------	-----------	--------	----------	--------	---------------------	------	-------	----

Сполука		BTM- Ag ₇ PS ₆	HTM- Ag ₇ PS ₆	Ag ₃ PS ₄	$Ag_7P_3S_{11}$	$Ag_4P_2S_7$	
ΠΓ		<i>F</i> -43 <i>m</i>	$P2_{I}3$	Pmn2 ₁	C2/c	C2/c	
Сингонія		кубічна	кубічна	орторомб.	моноклінна	моноклінна	
Иd	Лінійні, нм	a	1,0502	1,036	0,7650	2,3970	1,0778
eT		b			0,8680	0,6361	0,6534
aM		С			0,6509	2,4880	1,6211
IIap	Кутові					β=110,8°	β=106,8°
Література		[26]	[27]	[25]	[28]	[29]	

1.2.2.3. Ізотермічний переріз системи Ag₂S – GeS₂ – P₂S₅ [30]

При складі 60 мол. % $Ag_2S - 20$ мол. % $GeS_2 - 20$ мол. % P_2S_5 переріз Ag_3PS_4 – GeS_2 перетинається з перерізом між сполуками Ag_2GeS_3 та $Ag_4P_2S_7$. Всі інші перерізи розміщуватимуться в межах $P_2S_5 - Ag_3PS_4 - Ag_{10}Ge_3S_{11} - GeS_2$ лише так як представлено на ізотермічниму перерізі цієї квазіпотрійної системи (рис.1.9).

Між 10 однофазними полями, при 500 К (Ag₂S, GeS₂, α -P₂S₅, δ -Ag₈GeS₆, Ag₁₀Ge₃S₁₁, Ag₂GeS₃, β -Ag₇PS₆, ζ -Ag₃PS₄, Ag₄P₂S₇, AgPS₃) лежить 17 областей двофазних рівноваг: Ag₂S- β , β - ζ , ζ -Ag₄P₂S₇, Ag₄P₂S₇ – AgPS₃, AgPS₃- α , Ag₂S- δ , δ -Ag₁₀Ge₃S₁₁, Ag₁₀Ge₃S₁₁ – Ag₂GeS₃, Ag₂GeS₃ – GeS₂, GeS₂- α , β - δ , ζ - δ , ζ -Ag₁₀Ge₃S₁₁, ζ -Ag₂GeS₃, ζ -GeS₂, Ag₄P₂S₇ – GeS₂, AgPS₃ – GeS₂, які поділяють концентраційний трикутник на 8 трифазних полів. При цій температурі, як видно із перерізу дуже велика розчинність на основі BTM-Ag₈GeS₆ (до 90 мол. % Ag₇PS₆). Тому є значними двофазні області Ag₂S – BTM-Ag₈GeS₆ та BTM-Ag₈GeS₆ – Ag₁₀Ge₃S₁₁.

Синтезовані зразки за температури 500 К є двофазними як в частині $Ag_2S - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ ($Ag_2S + BTM-Ag_8GeS_6$), так і між Ag_3PS_4 , Ag_7PS_6 і $Ag_{10}Ge_3S_{11}$ ($Ag_3PS_4 + BTM-Ag_8GeS_6$). Однак BTM- Ag_8GeS_6 (ПГ *F-43m*) швидко, незалежно від умов відпалу та гарту, переходить у HTM-Ag_8GeS_6 (ПГ *P2*₁3).



в частині $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$ (б) при 500 К

1.2.2.4. Система Ag₈GeS₆- Ag₇PS₆

В літературі [30, 31], побудовано за результати ДТА та РФА систему $Ag_8GeS_6 - Ag_7PS_6$ (рис. 1.11.), яка є є квазібінарним перерізом квазіпотрійної системи Ag_2S – $GeS_2 - P_2S_5$ і характеризується повною взаємною розчинністю компонентів між ВТ-модифікаціями цих сполук ($Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$).



Рис.1.11. Діаграма стану системи Ag_7PS_6 – $Ag_8GeS_6 (1 - L; 2 - L + \delta; 3 - \delta; 4 - \gamma; 5 - \gamma + \delta; 6 - \delta + \beta; 7 - \beta)$

На кривих ліквідусу та солідусу немає точок екстремуму (І тип за Розебомом). Як видно з цієї діаграми стану при 500 К двофазною є лише область в невеликому інтервалі від 90 мол. % до ~95 мол. % Ag₇PS₆ між твердими розчинами ВТ модифікації

А $g_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$, (ПГ *F*-43*m*) та НТМ А g_7PS_6 , (ПГ *P*2₁3), а не між НТ модифікаціями вихідних сполук.

Висновки з літературного огляду

Діаграми стану подвійних систем вивчені повністю. У них утворюються сполуки різних складів, в тому числі Ag₂S, GeS₂, які відносяться до дальтонідів і плавляться конгруентно.

При дослідженні квазіподвійної системи $Ag_2S - GeS_2$ встановлено утворення сполук з конгруентним характером плавлення Ag_8GeS_6 , Ag_2GeS_3 та Ag_4GeS_4 з інконгруентним плавленням.

На перерізі $Ag_2S - Ag_4P_2S_7$ утворюються сполуки: Ag_7PS_6 , $Ag_3PS_4 Ag_7P_3S_{11}$, $Ag_4P_2S_7$. І лише Ag_7PS_6 утворюється конгруентно; всі інші за складнішим механізмом (твердофазно чи інконгруентно).

В квазіпотрійній системі $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$ взаємодію між сполуками досліджено при 500 К. Так як в цій системі одна із сполук ($Ag_7P_3S_{11}$) існує вище 574 К, то в роботі встановлюватимуться рівноваги між заявленими сполуками при 670 К. Також досліджуватимуться фазові рівноваги між Ag_7PS_6 та Ag_8GeS_6 .

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

2.1. Характеристика вихідних речовин та методів синтезу

Синтез зразків досліджуваних систем Ag - S, Ge - S, $Ag_2S - GeS_2$,

 $Ag_2S - P_2S_5$ проводили з простих речовин чистотою не менше 99,99 мас. %. Талій додатково очищали механічним шляхом від оксидної плівки. При синтезі зразків меркурійвмісних систем використовували попередньо отримані бінарні халькогеніди шляхом нагрівання вихідних простих речовин зі швидкістю 15 К/год до 670 К з витримкою 24 год, потім до 870 К (витримка 10 год), а тоді охолоджували до кімнатної температури.

Розраховані кількості вихідних простих, бінарних чи більш складних речовин зважували на аналітичних терезах ВЛР-200 з точністю до ±0,0001 г. Загальна маса наважки становила від 0,7 до 1,5 г. Компонування шихти здійснювали у кварцові контейнери (попередньо промиті водними розчинами соди, нітратної кислоти, дистильованою водою та висушені) з допомогою калькової лійки для запобігання запилення верхньої частини контейнера і мінімізації втрати вихідних речовин. Вакуумований до залишкового тиску 1,33·10⁻² Па кварцевий контейнер герметизували на киснево-газовому пальнику.

Виходячи з фізико-хімічних властивостей вихідних речовин був обраний однотемпературний метод синтезу, для якого використовували промислові печі типу СШОЛ–0.1,6/12-МЗ-У4-2 (ТУ 16.531.437-80) із системою регулювання і підтримки температури. Зразки спочатку нагрівали до температури 670 К зі швидкістю 30 К/год, за якої витримували впродовж доби (для зв'язування сірки), а потім до 1220 К із зупинками на 10 год через кожні 100 град. При максимальній температурі витримували 5 год. Охолоджували розплави з швидкістю 10 К/год до температури гомогенізуючого відпалу (500 або 670 К), який становив 250–500 год. Ампули з відпаленими сплавами гартували у холодній воді.

В додатку 2 наведено розрахунок наважок вихідних речовин для компоновки зразків перерізу Ag₃PS₄ – Ag₈GeS₆.

2.2. Рентгенофазовий аналіз

Рентгенівські методи дослідження в хімії використовується для вивчення структури кристалічних матеріалів та молекулярних сполук. Ці методи базуються на взаємодії рентгенівських променів з атомами у зразку, що дозволяє отримати інформацію про розташування атомів у кристалічній ґратці та їхні взаємодії. Рентгенівська кристалографія є потужним інструментом для вивчення хімічної структури різних матеріалів, включаючи білки, фармацевтичні сполуки, метали та мінерали.

Фізичні основи рентгенівського фазового аналізу

У методі РФА використовується явище дифракції рентгенівських променів на кристалічних ґратках, застосовується випромінювання з довжиною хвилі λ, що близька до величин міжатомних відстаней у кристалі. Принципи РФА В основі РФА лежать наступні принципи: порошкова дифракційна картина є індивідуальною характеристикою кристалічної речовини; кожна однаковий дифракційний кристалічна фаза дає завжди спектр. ШО характеризується набором міжплощинних відстаней *d* (*hkl*) і відповідних інтенсивностей ліній *I (hkl)*, що характерні тільки для певної кристалічної фази; рентгенодифракційнийй спектр від суміші індивідуальних фаз є суперпозицією їх дифракційних спектрів; по дифракційному спектру суміші можлива кількісна оцінка співвідношення кристалічних фаз, присутніх в зразку, що вивчається. Співвідношення інтенсивностей присутніх в конкретному зразку кристалічних фаз пропорційне вмісту фаз у ньому.

Проходження рентгенівських променів через речовину супроводжується різними видами взаємодії, одним з яких є розсіювання рентгенівських променів: речовина, яка піддається дії рентгенівського випромінювання, випускає вторинне випромінювання, довжина хвилі якого дорівнює довжині хвилі променів, що падають (когерентне розсіювання). Оскільки відстань між атомами близька до довжини хвилі вторинного когерентного випромінювання, то кристал може служити для нього дифракційною ґраткою. Кристал представляють як просторову структуру, що складається з паралельних, рівновіддалених одна від одної площин (*hkl*). Відповідно до розташування атомів у кристалічних гратках систему паралельних площин можна проводити різним чином, при цьому будуть різними відстані d_{hkl} між сусідніми площинами. Якщо взяти одну з таких атомних площин і припустити, що на неї падає під кутом θ рентгенівський промінь, то він буде вільно проходити через одноатомний шар, але за принципом Гюйгенса одночасно має місце і часткове відбиття променів під тим же кутом θ . При заданій величині d_{hkl} різниця ходу між променями складає: $\delta = 2 \cdot d_{hkl} \cdot sin \theta$.

Обидва відбитих промені будуть максимально підсилюватися тільки в тому випадку, коли різниця ходу складає цілу кількість хвиль, тобто за умови $2 \cdot d_{hkl} \cdot sin \theta = n \cdot \lambda$, де λ – довжина хвилі рентгенівського випромінювання, n – ціле число. Рівняння називається рівнянням Вульфа-Брега, а кут θ – брегівським кутом. Це рівняння лежить в основі усіх рентгенівських методів дослідження кристалічних тіл. Його використовують для розрахунку міжплощинних відстаней d, які власне є характеристикою конкретної кристалічної гратки. Виконання умови Вульфа-Брега при зміні кута падіння рентгенівського випромінювання реєструється на рентгенограмі виникненням максимуму. Інтенсивність цього максимуму відповідає інтенсивності відбитого променя, яка у свою чергу залежить від кількості атомів, що становлять це сімейство плошин. Тому інтенсивність відбитого променя також £ характеристикою об'єкту, що вивчається.

Якісний рентгенофазовий аналіз

Якісний фазовий аналіз проводять порівнянням експериментальних значень міжплощинних відстаней і відносних інтенсивностей з еталонними рентгенограмами, оскільки кожна речовина має свою «картину» розташування ліній на рентгенограмі. Якісний рентгенофазовий аналіз дозволяє розділяти і ідентифікувати окремі фази гетерогенної системи. Об'єктами дослідження у фазовому аналізі є метали, сплави, хімічні сполуки, мінерали, руди. За допомогою рентгенофазового аналізу можна визначати склад неметалічних включень в металах (оксидів, сульфідів, нітриду, карбідів), розподіл легуючих елементів у багатофазних сплавах. Широке застосування рентгенофазового аналізу пояснюється добре розробленою теорією, простотою приготування зразків, відносною експресністю отримання якісних результатів, можливістю використання полікристалічного матеріалу, можливістю масових аналізів та розрізнення поліморфних модифікацій, можливістю отримання 3 експериментальної дифрактограми, разом з даними про фазовий склад, даних про структурні характеристики окремих фаз і їх кількість. Якісний РФА – це ідентифікація кристалічних фаз на основі властивих їм значень міжплощинних відстаней d_{hkl} і інтенсивності ліній I_{hkl} дифрактограми. Кожна фаза має свою кристалічну гратку і характеризується тільки їй властивим набором міжплощинних відстаней d_{hkl}, що визначаються з формули рівняння Вульфа-Брега. Рентгенограма багатофазної системи є результатом накладення ліній різних фаз. Визначення фазового складу досліджуваної речовини проводять шляхом порівняння експериментального набору значень 2θ , d_{hkl} і I/I_o знайдених з рентгенівських спектрів із табличними значеннями, що представлені в різних базах даних [32].

Дослідження (ідентифікаційно) кристалічної структури потрійних сульфідів та при побудову ізотермічних перерізів квазіпотрійної системи Ag₂S – Ag₄P₂S₇ – GeS₂ проводили рентгенофазовим методом аналізу. Проводився він шляхом порівняння порошкограм зразків між собою та з отриманими еталонними і теоретично розрахованими (програма Powder Cell 2.3 [33]) порошкограмами бінарних та тернарних сполук. Дифрактограми одержували з допомогою дифрактометра ДРОН 4-13 [34,] (CuK_α–випромінювання, K_β-фільтр – Ni, зйомка по точках в інтервалі кутів $10^{\circ} \le 2\theta \le 80^{\circ}$ у кроковому режимі сканування ($\Delta 2\theta = 0,05^{\circ}$), час експозиції в кожній точці – 3-5 с).

2.3. Диференціально-термічний аналіз (ДТА)

Диференціально-термічний аналіз (ДТА) – це метод дослідження, який використовується для вивчення фізико-хімічних властивостей матеріалів шляхом вимірювання залежності температури від часу або температури від іншої змінної під час нагрівання або охолодження. Цей метод дозволяє виявити фазові перетворення, кристалізацію, плавлення, окислення та інші процеси, що відбуваються в матеріалі.

При диференціальному термічному аналізі записують температуру зразка і різницю температур між зразком і еталоном, який не має фазових перетворень. До початку перетворення зразок і еталон рівномірно нагріваються і при правильно вибраному еталоні різниця температур між ними близька до нуля.

Під час перетворення швидкість нагрівання або охолодження зразка змінюється (наприклад, в разі ізотермічного процесу температура зразка залишається постійною), а еталон продовжує нагріватися або охолоджуватися. Тому різниця температур зразка і еталону зростає і досягає максимуму до моменту кінця перетворення. Надалі температура швидко зменшується до значення, близького до нуля. Таким чином, на диференціальній кривій з'являється екстремум, який відповідає кінцю перетворення [35].

Зразки систем $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$ досліджували методом диференційно-термічного аналізу (ДТА) на установці, яка складалася з печі із регульованим нагрівом «Термодент-03» фірми НТФ Прогрет, блоку підсилення сигналу термопари (Pt/Pt-Rh термопара). Рівномірний нагрів печі здійснювали за допомогою програмного управління, зі швидкістю 10 К/хв, охолодження – в інерційному режимі. Максимальна температура нагріву становила 1270 К, що є граничною для використаної апаратури. Як еталон використовували Al₂O₃, попередньо прожарений тривалістю 10 год при 1270 К, а реперними речовинами виступали Sn, Cd, Te, Sb, NaCl, Ge, Ag i Cu. Досліджувані зразки, реперні речовини та еталон завантажували у контейнери Степанова, які 1.33·10⁻² Па і запаювали. вакуумували ло залишкового тиску Maca досліджуваної речовини становила ~ 1 г.

Висновки до методики експерименту

У розділі описана методика експерименту, включаючи характеристику вихідних речовин та методу синтезу сплавів в межах досліджувальної системи $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$. Максимальна температура синтезу складала 1270 К, відпал протягом 10 годин здіснювали при 670 К.

Для аналізу структури кристалічних матеріалів та молекулярних сполук використовувався рентгенофазовий аналіз, який базується на дифракції рентгенівських променів на кристалічних ґратках (установка ДРОН 4-13 СиК_{α}–випромінювання, К_{β}-фільтр – Ni, зйомка по точках в інтервалі кутів 10° \leq 2 θ \leq 80° у кроковому режимі сканування ($\Delta 2\theta$ =0,05°), час експозиції в кожній точці – 3-5 с).

Для вивчення фізико-хімічних властивостей сплавів використовувався диференціально-термічний аналіз (ДТА), шляхом вимірювання залежності температури від часу під час нагрівання або охолодження (установка, яка складається з печі із регульованим нагрівом «Термодент-03» фірми НТФ Прогрет, блоку підсилення сигналу термопари (Pt/Pt-Rh термопара).

РОЗДІЛ З. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Для вивчення фізико-хімічної взаємодії у системі $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$ необхідна інформація про обмежуючі сторони. Такими обмежуючими є системи $Ag_2S - Ag_4P_2S_7$ [25] і $Ag_2S - GeS_2$ [16]. Перша обмежуюча це частина системи

 $Ag_2S - P_4S_{10}(2P_2S_5)$, в якій утворюються п'ять сполук; в межах заданих складів знаходиться чотири сполуки (рис. 3.1, *a*): Ag_7PS_6 , Ag_3PS_4 , $Ag_7P_3S_{11}$, та $Ag_4P_2S_7$ (остання відповідає 20 мол. % P_4S_{10}). Для кращого сприйняття цю частину системи розтягуємо до 100 мол. % (рис. 3.1. *б*).



Рис. 3. 1. Діаграма стану системи Ag₂S – P₂S₅: в інтервалі 0-100 мол.% P₄S₁₀ (*a*) [25] та 0-100 мол.% Ag₄P₂S₇ (*б*)

3.1. Ізотермічний переріз системи при 670 К

Попередньо досліджено ізотермічний переріз системи $Ag_2S - P_2S_5 - GeS_2$ при 500 К [30], де між між 10 однофазними полями (Ag_2S , GeS_2 , α - P_2S_5 , δ- Ag₈GeS₆, Ag₁₀Ge₃S₁₁, Ag₂GeS₃, β-Ag₇PS₆, ζ-Ag₃PS₄, Ag₄P₂S₇, AgPS₃) лежать 17 областей двофазних рівноваг, які поділяють концентраційний трикутник на 8 трифазних полів. При цій температурі, як видно із перерізу Ag₇PS₆ – Ag₈GeS₆ дуже велика розчинність на основі BTM-Ag₈GeS₆ ПГ *F*-43*m* (до 90 мол. % Ag₇PS₆). Тому є значними двофазні області Ag₂S – BTM-Ag₈GeS₆ та BTM-Ag₈GeS₆ – Ag₁₀Ge₃S₁₁.

Так як сполука Ag₇P₃S₁₁ існує в інтервалі 574 (температура твердофазного утворення)-857 К (температура перитектичного розпаду), тому виникла необхідність провести дослідження взаємодії при температурах близьких до 600-700 К.

Побудований за результатами РФА ізотермічний переріз системи $Ag_2S - P_2S_5 - GeS_2$ при 670 К наведено на (рис. 3.2, *a*), а в межах $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2 - Ha$ рис. 3.2, *б*.

Якщо між сполуками аргіродитного типу по перерізу $Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ (рис. 1.11 [30, 31]) при 500 К присутні тверді розчини на основі HTM-Ag₇PS₆ (ПГ *P*213), BTM-Ag₈GeS₆ (ПГ *F*-43*m*) та двофазна область між ними, то при 670 К існує лише необмежений ряд твердих розчинів кубічної структури (BTM-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆, ПГ *F*-43*m*). Це відображається і на ізотермічному перерізі Ag₂S – Ag₄P₂S₇ – GeS₂ при 670 К: маємо б'-твердий розчин між високотемпературними модифікаціями сполук Ag₇PS₆ та Ag₈GeS₆, які є ізоструктурними. Через що між трьома сполуками Ag₂S, Ag₇PS₆ та Ag₈GeS₆ існує двофазна область.

Отже, при 670 К 8 однофазних полів (Ag₂S, δ'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆, ζ-Ag₃PS₄, Ag₇P₃S₁₁, Ag₄P₂S₇, Ag₁₀Ge₃S₁₁, Ag₂GeS₃, GeS₂) утворюють 12 областей двофазних piвноваг (Ag₂S+ δ'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆, δ'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆+ζ-Ag₃PS₄, ζ-Ag₃PS₄+Ag₇P₃S₁₁, Ag₇P₃S₁₁+Ag₄P₂S₇, δ'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆+Ag₁₀Ge₃S₁₁, Ag₁₀Ge₃S₁₁+Ag₂GeS₃, Ag₂GeS₃+GeS₂, ζ-Ag₃PS₄+Ag₁₀Ge₃S₁₁, ζ-Ag₃PS₄+Ag₂GeS₃, ζ-Ag₃PS₄+GeS₂, Ag₇P₃S₁₁+GeS₂, Ag₄P₂S₇+GeS₂), які поділяють концентраційний трикутник на 5 полів трифазних взаємодій (ζ-Ag₃PS₄+Ag₁₀Ge3S₁₁+ δ '-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆, ζ-Ag₃PS₄+Ag₁₀Ge₃S₁₁+Ag₂GeS₃, ζ-Ag₃PS₄+Ag₂GeS₃+GeS₂, Ag₇P₃S₁₁+ ζ-Ag₃PS₄+GeS₂, Ag₄P₂S₇+Ag₇P₃S₁₁+GeS₂).





Рис. 3.2. Ізотермічний переріз підсистеми $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$ при 670 К

3.2. Політермічний переріз Ag₃PS₄ – Ag₈GeS₆

Першим політермічним перерізом, що побудований в досліджуваній системі, є переріз Ag₇PS₆ – Ag₈GeS₆ (рис. 1.11) [30,31].

Наступний політермічний переріз Ag₃PS₄ – Ag₈GeS₆, який нами побудовано, є двофазною рівновагою в підсолідусній області. На це вказують ізотермічні перерізи при 500 та 670 К.

Результати РФА зразків системи Ag₃PS₄ – Ag₈GeS₆ у вигляді типових дифрактограм наведені на рис. 3.3. Вони підтверджують результати роботи [31]; а саме, що в підсолідусній області цей переріз є двофазною рівновагою.



Рис. 3.3. Дифрактограми зразків політермічного перерізу $Ag_3PS_4 - Ag_8GeS_6$

До 50 мол. % Ag₈GeS₆ сплави є двофазними (Ag₃PS₄+Ag₈GeS₆). Кубічна структура ПГ *F*-43*m* характерна для зразків складів, близьких до 70 мол. % Ag₈GeS₆. Поблизу арґіродитної сполуки незважаючи на відпал при 670 К з пониженням температури до кімнатної BTM-Ag₈GeS₆ (ПГ *F*-43*m*) переходить доволі швидко в HTM-Ag₈GeS₆ (*Pna*2₁). Процес евтектоїдного розпаду BTM-Ag₈GeS₆ (δ -Ag₈GeS₆ (δ) (δ -Ag

Цей переріз є частиною значного двофазного поля в підсолідусній області (Ag₃PS₄+ δ-Ag₈GeS₆).

Діаграма стану перерізу Ag₃PS₄ – Ag₈GeS₆, що побудована за результатами ДТА, наведена на рис. 3.4.



Рис.3.4. Діаграма стану політермічного перерізу $Ag_3PS_4 - Ag_8GeS_6$

Крива первинної кристалізації твердого розчину δ' -Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆ опускається від ліквідусу сполуки Ag₈GeS₆ до точки ліквідусу складу сполуки Ад₃PS₄. Від температури перитектики з обмежуючої (857 К), якій відповідає процес L+Ag₇PS₆ \leftrightarrow Ag₇P₃S₁₁ перерізу Ag₂S – P₄S₁₀(2P₂S₅), опускається крива вторинної кристалізації L+ δ' -Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆+Ag₇P₃S₁₁ на перитектичну площину процесу $L+\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_{x}S_{6}\leftrightarrow\delta'-Ag_{3}PS_{4}+Ag_{10}Ge_{3}S_{11}$. Горизонталь при 803 К належить твердофазному утворенню Ag₃PS₄. Розчинність на основі Ag₈GeS₆ становить ~40 мол. % при температурі відпалу (670 К). Від 493 К починається BTM-Ag₈GeS₆ евтектоїдно розпадатися $(\delta - Ag_8GeS_6 \leftrightarrow Ag_3PS_4 + \delta - Ag_8GeS_6).$ Температури фазових перетворень наведені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1.

T	1			•		
	empenational day	ODUV ПАЛАТОЛ	Neul D CHHADAY	$\pi eneni2W$	$\Delta \sigma_{2} P S_{4} =$	$\Delta \sigma_{0}$ test
1	CIVILICIDAL VIEL WA		ропо о спларал		$ng_{1} 04 -$	AEXUUD6
	1 21 1		1		0	\mathcal{U}°

	Скла	ид, мол. %	
N⁰	Ag ₃ PS ₄	Ag_8GeS_6	Температура К
1	100	0	803, 857, 900

2	90	10	800, 832, 852, 1020
3	80	20	803, 834, 850, 1051
4	70	30	801, 835, 845, 1080
5	60	40	840, 1090
6	50	50	835, 1110
7	40	60	660, 842, 1100
8	30	70	425, 900, 1147
9	20	80	450, 953, 1156
10	10	90	440, 490, 1200
11	0	100	493, 1223

3.3. Проекція поверхонь ліквідуса

3.3.1. Підсистема Ag₂S – Ag₇PS₆ – Ag₈GeS₆

Побудовано в роботі дві проекції поверхонь ліквідуса для підсистем $Ag_2S - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ та $Ag_3PS_4 - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ з використанням результатів РФА та ДТА. В літературних джерелах є відомості, що до взаємодії компонентів в усіх трьох обмежуючих сторонах першої підсистеми та двох другої. В цій роботі побудовано політермічний переріз $Ag_3PS_4 - Ag_8GeS_6$, який є третьою обмежуючою другої підсистеми.

Для вивчення взаємодії у підсистемі $Ag_2S - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ було синтезовано 7 сплавів (рис. 3.5, *a*). Склади сплавів підбирали таким чином, щоб вони рівновіддалено лягали на прямі, що відповідають ізоконцентратам 15 мол. % кожного компонента та один – вздовж висоти трикутника цієї підсистеми від Ag_2S. Взаємодія між Ag_2S – Ag_7PS_6 [27] та Ag_2S – Ag_8GeS_6 [17] є евтектичного типу, а між Ag_7PS_6 – Ag_8GeS_6 утворюється неперервний рядів твердих розчинів [31,30].

a



Рис. 3.5. Поверхня ліквідусу підсистеми $Ag_2S - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$

Температури первинної кристалізації сплавів (табл. 3.2) у комплексі з літературними даними використовувалися для побудови проекції поверхні ліквідусу. За результатами, що одержано з врахуванням експериментальних

даних термічного аналізу, побудовано проекцію ліквідусу на концентраційний трикутник квазіпотрійної підсистеми $Ag_2S - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ (рис. 3.5, δ). Діаграма стану цієї системи відноситься до типу діаграм стану з моноваріантною евтектичною рівновагою $L \leftrightarrow BTM-Ag_2S + \delta' - Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$, що обмежена двома квазіподвійними системами $Ag_2S - Ag_7PS_6$ та $Ag_2S - Ag_8GeS_6$ евтектичного типу, та системою $Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$, в якій утворюються неперервні ряди твердих розчинів ($\delta' - Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$ -твердий розчин) на основі тернарних сполук. Первинній кристалізації BTM Ag_2S відповідає поверхня: $Ag_2S-e_1-e_2-Ag_2S$, а первинній кристалізації δ' -твердого розчину на основі $Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$ поверхня: $Ag_7PS_6-e_1-e_2-Ag_8GeS_6$. Евтектичний процес $L \leftrightarrow BTM-Ag_2S+\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$ проходить в інтервалі температур 1081-1011 К зі сторони $Ag_2S - Ag_8GeS_6$, а тому є моноваріантним (лінія моноваріантної рівноваги e_1-e_2).

Таблиця 3.2.

		Склад, мо.		
N⁰	Ag ₂ S	Ag ₇ PS ₆	Ag_8PS_6	Температура, К
1	70	15	15	1077, 1062
2	42.5	42.5	15	1072, 1035
3	42.5	27.5	28	1090, 1057
4	42.5	15.5	42	1127, 1102
5	15	70	15	1080, 1037
6	15	41	44	1149, 1072
7	15	16	69	1184, 1126
8	60	20	20	1059, 1048

Температура фазових перетворень в межах Ag₂S – Ag₇PS₆ – Ag₈GeS₆

Наступною вивчалася підсистема Ag₇PS₆ – Ag₃PS₄ – Ag₈GeS₆, так як всі три її обмежуючі побудовані (дві відомі з літератури; третя побудована нами). Було синтезовано 7 сплавів (рис. 3.6, *a*), аналогічно до попередньої підсистеми.

3.3.2. Підсистема Ag₃PS₄ – Ag₇PS₆ – Ag₈GeS₆



Рис. 3.6. Поверхня ліквідусу підсистеми Ag₇PS₆ – Ag₃PS₄ – Ag₈GeS₆

За результатами літературних джерел та даних дослідження (рис. 3.3) синтезованих зразків побудовано проекцію поверхні ліквідусу (рис. 3.6, б), яка

складається з одного поля первинної кристалізації фази δ' -Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆ – твердого розчину, що утворюється між ВТМ сполук Ag₇PS₆ та Ag₈GeS₆ кубічної структури, що демонструє побудована діаграма стану цього політермічного перерізу (рис. 3.4).

Таблиця 3.3.

		Склад, мо.		
N⁰	Ag ₃ PS ₄	Ag ₇ PS ₆	Ag_8PS_6	Температура, К
1	15	70	15	1108
2	42.5	42.5	15	1067
3	28	42.5	29.5	1115
4	17.5	42.5	40	1153
5	70	15	15	1056
6	42.5	15	42.5	1120
7	15	15	70	1175

Температури фазових перетворень в межах $Ag_7PS_6 - Ag_3PS_4 - Ag_8GeS_6$

Висновки експериментальної частини

Побудовано за результатами РФА отриманих сплавів та літературними даними ізотермічний переріз підсистеми Ag₂S – Ag₄P₂S₇ – GeS₂ при 670 K; виявлено одну додаткову рівновагу в цій системі Ag₇P₃S₁₁– GeS₂.

Побудовано за результатами РФА та ДТА діаграму стану політермічного перерізу Ag₃PS₄ – Ag₈GeS₆, яка виявилась триангулюючою підсолідосним області (двофазною).

Побудовано дві проекції поверхонь ліквідуса для підсистем $Ag_2S - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ та $Ag_3PS_4 - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6$ з використанням літературних даних та результатів РФА та ДТА синтезованих зразків. В першій підсистемі первинно кристалізується дві фази (Ag_2S та δ'-твердий розчин на основі ВТМ ПГ (*F*-43*m*) Ag_7PS_6 та Ag_8GeS_6 ($Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$)). В другій підсистемі продовжує кристалізуватись δ'-твердий розчин ($Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$).

ВИСНОВКИ

Для вивчення фізико-хімічної взаємодії у системі $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$ використовували інформацію про обмежуючі сторони $Ag_2S - Ag_4P_2S_7$ і $Ag_2S - GeS_2$. Перша обмежуюча це частина системи $Ag_2S - P_4S_{10}$ ($2P_2S_5$), в якій утворюються п'ять сполук; в межах заданих складів знаходиться чотири сполуки: Ag_7PS_6 , Ag_3PS_4 , $Ag_7P_3S_{11}$, та $Ag_4P_2S_7$ (остання відповідає 20 мол. % P_4S_{10}). В другій $Ag_2S - GeS_2$ утворюються три сполуки: Ag_8GeS_6 , Ag_4GeS_4 , Ag_2GeS_3 . Так як сполука $Ag_7P_3S_{11}$ існує в інтервалі 574 (температура твердофазного утворення)-857 К (температура перитектичного розпаду), тому виникла необхідність провести дослідження взаємодії при температурах близьких до 600-700 К.

Побудований за результатами РФА ізотермічний переріз системи при

670 К наведено в межах $Ag_2S - Ag_4P_2S_7 - GeS_2$. При цій температурі утворюються 8 однофазних полів (Ag_2S , $\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$, $\zeta-Ag_3PS_4$, $Ag_7P_3S_{11}$, $Ag_4P_2S_7$, $Ag_{10}Ge_3S_{11}$, Ag_2GeS_3 , GeS_2) утворюють 12 областей двофазних рівноваг ($Ag_2S + \delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$, $\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6+\zeta-Ag_3PS_4$, $\zeta-Ag_3PS_4+Ag_7P_3S_{11}$, $Ag_7P_3S_{11}+Ag_4P_2S_7$, $\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6+Ag_{10}Ge_3S_{11}$, $Ag_{10}Ge_3S_{11}+Ag_2GeS_3$, $Ag_2GeS_3+GeS_2$, $\zeta-Ag_3PS_4+Ag_{10}Ge_3S_{11}$, $\zeta-Ag_3PS_4+Ag_2GeS_3$, $\zeta-Ag_3PS_4+GeS_2$, $Ag_7P_3S_{11}+GeS_2$, $Ag_4P_2S_7+GeS_2$), які поділяють концентраційний трикутник на 5 полів трифазних взаємодій ($\zeta-Ag_3PS_4+Ag_{10}Ge_3S_{11}+\delta'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$,

 $\zeta - Ag_3 PS_4 + Ag_{10}Ge_3 S_{11} + Ag_2 GeS_3, \ \zeta - Ag_3 PS_4 + Ag_2 GeS_3 + GeS_2, \ Ag_7 P_3 S_{11} + \zeta - Ag_3 PS_4 + GeS_2, \ Ag_4 P_2 S_7 + Ag_7 P_3 S_{11} + GeS_2).$

Побудовано політермічний переріз $Ag_3PS_4 - Ag_8GeS_6$. Цей переріз є двофазною рівновагою в підсолідусній області. Крива первинної кристалізації твердого розчину δ'- $Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6$ (кубічна структуру ПГ *F*-43*m*) опускається від ліквідусу сполуки Ag_8GeS_6 до точки ліквідусу складу сполуки Ag_3PS_4 . Від температури перитектики з обмежуючої (857 K), якій відповідає процес L+ $Ag_7PS_6 \leftrightarrow Ag_7P_3S_{11}$ перерізу $Ag_2S - P_4S_{10}(P_2S_5)$, опускається крива вторинної кристалізації L+ δ' - $Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6+Ag_7P_3S_{11}$ на перитектичну площину процесу

L+δ'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆↔δ'-Ag₃PS₄+Ag₁₀Ge₃S₁₁. Горизонталь при 803 К належить твердофазному утворенню Ag₃PS₄. Розчинність на основі Ag₈GeS₆ становить ~40 мол. % при температурі відпалу (670 К). Від 493 К починається евтектоїдно розпадатися BTM-Ag₈GeS₆ $(\delta' - Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6 \leftrightarrow Ag_3PS_4 + \delta' - Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS_6).$ Побудовано проекції поверхонь ліквідуса двох підсистем Ag₂S – Ag₇PS₆ – $Ag_8GeS_6 i Ag_3PS_4 - Ag_7PS_6 - Ag_8GeS_6 з використанням літературних даних по$ обмежуючих $Ag_2S - Ag_4P_2S_7$, $Ag_2S - GeS_2$ та по результатах власних досліджень політермічного перерізу Ag₃PS₄ – Ag₈GeS₆. Побудована діаграма стану системи Ag₂S – Ag₇PS₆ – Ag₈GeS₆ відноситься до типу діаграм стану з моноваріантною евтектичною рівновагою L↔BTM-Ag₂S+δ'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆, що обмежена двома квазіподвійними системами $Ag_2S - Ag_7PS_6$ та $Ag_2S - Ag_8GeS_6$ евтектичного типу, та системою Ag₇PS₆ – Ag₈GeS₆, в якій утворюються неперервні ряди твердих розчинів (δ'-Ag_{8-x}Ge_{1-x}P_xS₆-твердий розчин) на основі тернарних сполук. Проекція поверхні ліквідуса наступної підсистеми Ag₃PS₄ – Ag₇PS₆ – Ag₈GeS₆ складається з одного поля первинної кристалізації фази б'-Аg_{8-х}Ge_{1-х}P_xS₆ твердого розчину, що утворюється між ВТМ сполук Ag₇PS₆ та Ag₈GeS₆ кубічної структури (ПГ *F*-43*m*).

<u>Апробація результатів та публікації.</u> За деякими матеріалами роботи опубліковані тези в матеріалах VIII Міжнародної науково-практичної конференції «ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА: СТАН, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 18-19 жовтня 2024 р., м. Луцьк (Березнюк О.П., Зінич І.Б., Невидюк В.С., Алрікік М., Піскач Л.В. Взаємодія германій(станум)(IV) та фосфор(V) сульфідів з високим вмістом аргентум(I) сульфіду при 500 К. С. 12-13).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1. <u>https://corelamps.com/elementy/arhentum/</u>
- 2. <u>http://surl.li/egyeqi</u>
- 3. http://surl.li/tgucwd
- 4. <u>http://surl.li/uwdsrg</u>
- Sharma R. C., Chang Y. A. The Ag S (silver-sulfur) system. Bulletin of Alloy Phase Diagrams. 1986. Vol. 7, № 3. P. 263–269.
- Sadovnikov S.I., Gusev A.I., Churkin A.V., Rempel A.A. Hightemperature X-ray diffraction and thermal expansion of nanocrystalline and coarsecrustalline acantite ∞ Ag₂S and argentite β-Ag₂S. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016. Vol. 18. № 6. P. 4617–4626.
- Yakisheva N. P. Phase Diagrams of Binary Metallic Systems: Handbook. Vol. 1. Moscow: Mashinostroenie, 1996. 992 p.
- Kashida S., Watanabe N., Hasegawa T., Iida H., Mori M., Savrasov S. Electronic structure of Ag₂S, band calculation and photoelectron spectroscopy. *Solid State Ionics*. 2003. № 158. C. 167–175.
- Blanton T., Misture S., Dontula N., Zdzieszynski S. In situ high-temperature X-ray diffraction characterization of silver sulfide, Ag₂S. *Materials Science*. 2011. Vol. 26, № 2. P. 114–116. DOI: https://doi.org/10.1154/1.3583564
- H. Spandau, P. Klanberg, Ueber das thermische Verhalten der Sulfide des Germaniums, Z.anorg. Allg. Chem. 295, (5-6), S. 113-122. 1958
- Liu Chun Hua, A. S. Pashinkin, A. V. Novoselova, Research on the system Ge – S (russ.Dokl. Akad. Nauk SSSR, 151(6), 1335 (1963).
- 12. Dittmar G., Shäfer H. Die Kristallstructur von H.T.-GeS2. Acta Crystallographica. Section B. 1975. № 31. P. 2060–2064.
- 13. Dittmar G., Schäfer H. Die Kristallstructur von L.T.-GeS2. Acta Crystallographica. Section B. 1976. Vol. 32, № 4. P. 1188–1192.
- Gorochov O. Les composes Ag8MX6 (M=Si, Ge, Sn et X=S, Se, Te).
 Bulletin de la Société Chimique de France. 1968. Vol. 6. P. 2263–2275.

- 15. Кохан О. П. Взаємодія в системах Ag₂X–B^{IV}X₂ (B^{IV} Si, Ge, Sn; X S, Se) і властивості сполук: дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01. Ужгород, 1996. 21 с.
- A.V. Novoselova, V. P. Zlomanov, S. G. Karbanov, O. V. Matveyev, A. M. Gas'kov, Physico-chemical study of the germanium, tin and lead chalcogenides, Progress in Solid StateChem., Oxford: Pergamon Press 7, 85 (1972).
- 17. Kuhs W.F., Nitsche R., Scheunemann K. The argyrodites-a new family of the tetrahedrally close-packed structures. Mat. Res. Bull. 1979, 14, 241-248.
- Chbani N., Cai X., Loireau-Lozac'h A. M., Guittard M. Ternaire argentgermanium-sulfure. Quasibinaire disulfure de germanium – sulfure d'argent. Conductivite electrique du verre le plus riche en argent. Materials Research Bulletin. 1992. Vol. 27, № 11. P. 1355–1361.
- Salaeva Z. Yu., Movsum-zadeh A. A., Bagirov A. I., Skoropanov A. S. "Triple system Ag2S – GeS2 – S." *Inorganic Materials*, 1988, Vol. 33, No. 5, p. 1262–1267.
- 20. Movsum-zadeh A. A., Salaeva Z. Yu., Allazov M. R. "Triple system Ag Ge S." *Journal of Inorganic Chemistry*, 1987, Vol. 34, No. 9, p. 2324–2330.
- 21. Nagel A., Range K.-J. Verbindungs bildung im System Ag₂S GeS₂
 AgI. Zeitschrift für Naturforschung B. 1978. Vol. 33. P. 1461–1464.
- Kawaguchi T. Photoinduced surface deposition of Ag on Ag-rich Ag Ge S films: Optimal Ag content and film thickness for applications in optical recording devices. *Applied Physics Letters*. 1998. Vol. 72. P. 161–163.
- 23. Eulenberger G. Die Kristallstruktur der Tieftemperaturmodifikation von Ag₈GeS₆. *Monatshefte für Chemie*. 1977. Vol. 108. P. 901–913.
- 24. Жбанков О. С., Парасюк О. В., Федорчук А. О., Токайчук Я. С., Олексеюк І. Д. Кристалічні структури сполук Ag₂SiS₃, Ag₁₀Ge₃S₁₁ та Ag₂SnS₃. *Львівські хімічні читання – 2007*: збірн. наук. праць, м. Львів, 30 трав.-1 черв. 2007 р. Львів, 2007. С. 43.

- 25. Andrae H., Blachnik R. Metal sulphide-tetraphosphorusdekasulphide phase diagrams. *Journal of Allous and Compounds*. 1992. Vol. 189. P. 209–215. thermochemisches Verhalten von Ag₇MX₆-Verbindungen (M = P, As, Sb; X = S, Se). *Zeitschrift für Naturforschung B*. 1980. Vol. 35 b. P. 1268–1271. DOI: https://doi.org/10.1515/znb-1980-1019
- 26. Blachnik R., Wickel U. Phasenbeziehungen im System Ag–As–S und thermochemisches Verhalten von Ag₇MX₆-Verbindungen (M = P, As, Sb; X = S, Se). *Zeitschrift für Naturforschung B*. 1980. Vol. 35 b. P. 1268–1271. DOI: <u>https://doi.org/10.1515/znb-1980-1019</u>
- 27. Kuhs W. F., Nitsche R., Scheunemann K. The argyrodites A new family of the tetrahedrally close-packed structures. *Materials Research Bulletin*. 1979. Vol. 14, № 2. P. 241–248. DOI: https://doi.org/10.1016/0025-5408(79)90125-9
- Toffoli P., Khodadad P., Rodier N. Structure du tetrathiomonophosphate(V) heptathiodiphosphate(V) d'argent. *Acta Crystallographica B*. 1982. Vol. 38.
 P. 2374–2378. DOI :<u>https://doi.org/10.1107/S0567740882008838</u>
- Toffoli P., Khodadad P., Rodier N. Structure Cristalline du Pyrothiophosphate d'Argent, Ag₄P₂S₇. *Acta Crystallographica B*. 1977. Vol. 33. P. 1492–1494.
- 30. Березнюк О. П. Фазові рівноваги, склоутворення і властивості проміжних фаз у системах Cu(Ag) ₂S – Ge(Sn)S₂ – As(Sb)₂S₃ (P₂S₅) : дис.... д-ра філософії, спец. 102 - Хімія. - Волинський нац. ун-т. ім. Л. Українки, 2023, Ужгород, 180 с.
- 31. Стаття Березнюк по перерізу Ag₇PS₆ Ag₈GeS₆: Березнюк О. П., Смітюх О. В., Піскач Л. В. Взаємодія по перерізах Cu(Ag)₇PS₆ – Cu(Ag)₈Ge(Sn)S₆. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. Вип. 4. С. 3-16. DOI: https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-4-1.
- 32.chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ela.kpi.ua/ server/api/core/bitstreams/b07007ee-9f5d-4a6e-9588-896df382a1e0/content
- 33. Kraus W., Nolze G. Powder Cell for Windows. Berlin., 1999.

- 34. Rentgenovskii difraktometr DRON-4-13: Instruktsiya po ekspluatatsii. Leningrad, 1994. 100 p.
- 35. <u>https://studfile.net/preview/5995690/page:2/</u>
- 36. <u>https://chat-gpt-world.com/ua/</u>

ДОДАТКИ

Техніка безпеки при роботі з фосфором

Фосфор є високотоксичною та небезпечною речовиною, тому при роботі з ним необхідно дотримуватися ряду правил безпеки, щоб запобігти травмам, отруєнням і пожежам. Ось основні правила безпеки при роботі з фосфором.

Приміщення, в якому проводяться роботи з фосфором, повинно бути добре провітрюване. Рекомендується працювати в витяжних шафах або в місцях з примусовою вентиляцією, потрібно уникати яскравого освітлення, оскільки фосфор може горіти від впливу сильного світла. Фосфор повинен зберігатися в прохолодних умовах, оскільки він може самозайматися при високих температурах.

При роботі з фосфором необхідно носити спеціальну одяг (робочий халат), рукавички, окуляри для захисту очей і респіратор або маску для захисту органів дихання, обов'язково використовувати респіратор для захисту від вдихання токсичних парів фосфору, особливо коли робота проводиться в погано вентильованих приміщеннях.

Фосфор є токсичний, тому уникайте контакту з шкірою і очима, при роботі необхідно бути дуже обережним, дихати парами фосфору небезпечно, тому обов'язково використовувати засоби захисту органів дихання. Через високу горючість фосфору, не можна використовувати воду для гасіння пожежі. У разі пожежі потрібно застосовувати пісок, спеціальні порошкові вогнегасники або інші засоби, що не вступають в реакцію з фосфором.

При попаданні на шкіру фосфору, негайно змити великою кількістю води або обробити шкіру спеціальними нейтралізуючими розчинами (наприклад, розчином марганцевокислого калію). При попаданні в очі: ретельно промити очі великою кількістю води та звернутися до лікаря. Якщо фосфор потрапив в

50

організм, необхідно терміново звертатися за медичною допомогою. Отруєння ним може мати серйозні наслідки для здоров'я [36].

Додаток 2

Розрахунок наважок вихідних речовин для компоновки зразків перерізу Ag₃PS₄ – Ag₈GeS₆

"Ag ₃ PS ₄ / Ag ₈	GeS6" Ag	Р	S	Ge "		••	
"					•	•	
"0 / 100 "	1.147603	-	0.255862	0.096535	,	•	11
"10 / 90 "	1.141143	0.004369	0.262336	0.092152		, ''	10
"20 / 80 "	1.133847	0.009302	0.269648	0.087203		, 11 1	9
" 30 / 70	1.125545	0.014917	0.277969	0.08157		,,	8
"40 / 60 "	1.116011	0.021364	0.287523	0.075102	,	, ,,	7
"50 / 50 "	1.10495	0.028844	0.298608	0.067598	,	••• •	6
"60 / 40 "	1.091963	0.037626	0.311624	0.058787	,	, ,,	5
"70 / 30 "	1.076498	0.048084	0.327123	0.048295		, ,,	4
"80 / 20 "	1.057772	0.060747	0.345889	0.035592	,	, ,,	3
"90 / 10 "	1.034633	0.076395	0.36908	0.019893	,	,,	2
"100 / 0 "	1.005311	0.096223	0.398466		······································	•	1
···					,	•	
"	Ag	Р	S	Ge			

